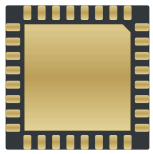
10–1100 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 40 dBm

LCI-PA-10-1100-PS40MIN · 10–1100 MHz · GaN Amplificador de potência encapsulado.



Valores da tabela RF: PSAT ≥ 40 dBm; Ganho de potência ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %. Condições de teste RF: TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW.

QFN32 5 × 5 mm

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

T_peak ≤ 260 °C

RFin / Vg: 4, 5

RFout / Vd: 20, 21

GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32

Dimensões do encapsulamento: 5 × 5 × 1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	10	-	1100	MHz
Potência de saída saturada	-	40	-	-	dBm
Ganho de potência	-	13	-	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	60	-	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	-	±0.5	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de dreno	-	-	-	-	28	V
Tensão de porta	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Potência de entrada máxima	-	-	-	27	dBm

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	5 × 5 × 1	mm

Atribuição dos terminais

Símbolo	Terminais	Função
GND	1,8,9,16,17,24,25,32	-
NIC	2,3,6,7,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23, 26,27,28,29,30,31	Sem conexão interna; pode ser ligado ao terra
RFin	4,5	Entrada RF / polarização de porta
RFout	20,21	Saída RF / polarização de dreno

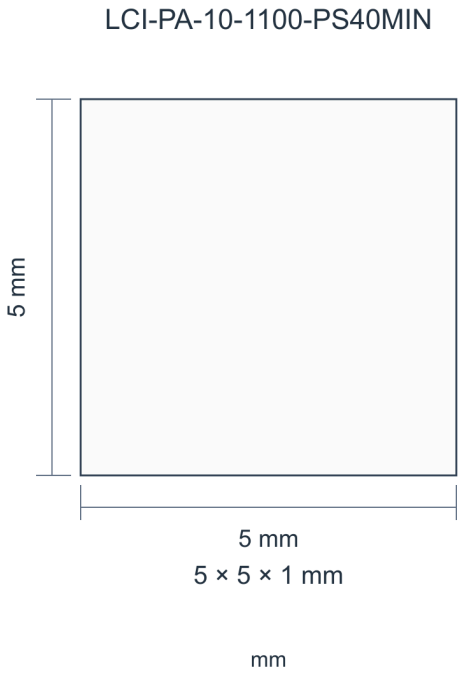
Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

Notas de integração

QFN32 5 × 5 mm Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF T_peak ≤ 260 °C RFin / Vg: 4, 5 RFout / Vd: 20, 21 GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32 O pad exposto na face inferior do encapsulamento deve ser conectado ao terra RF e DC.

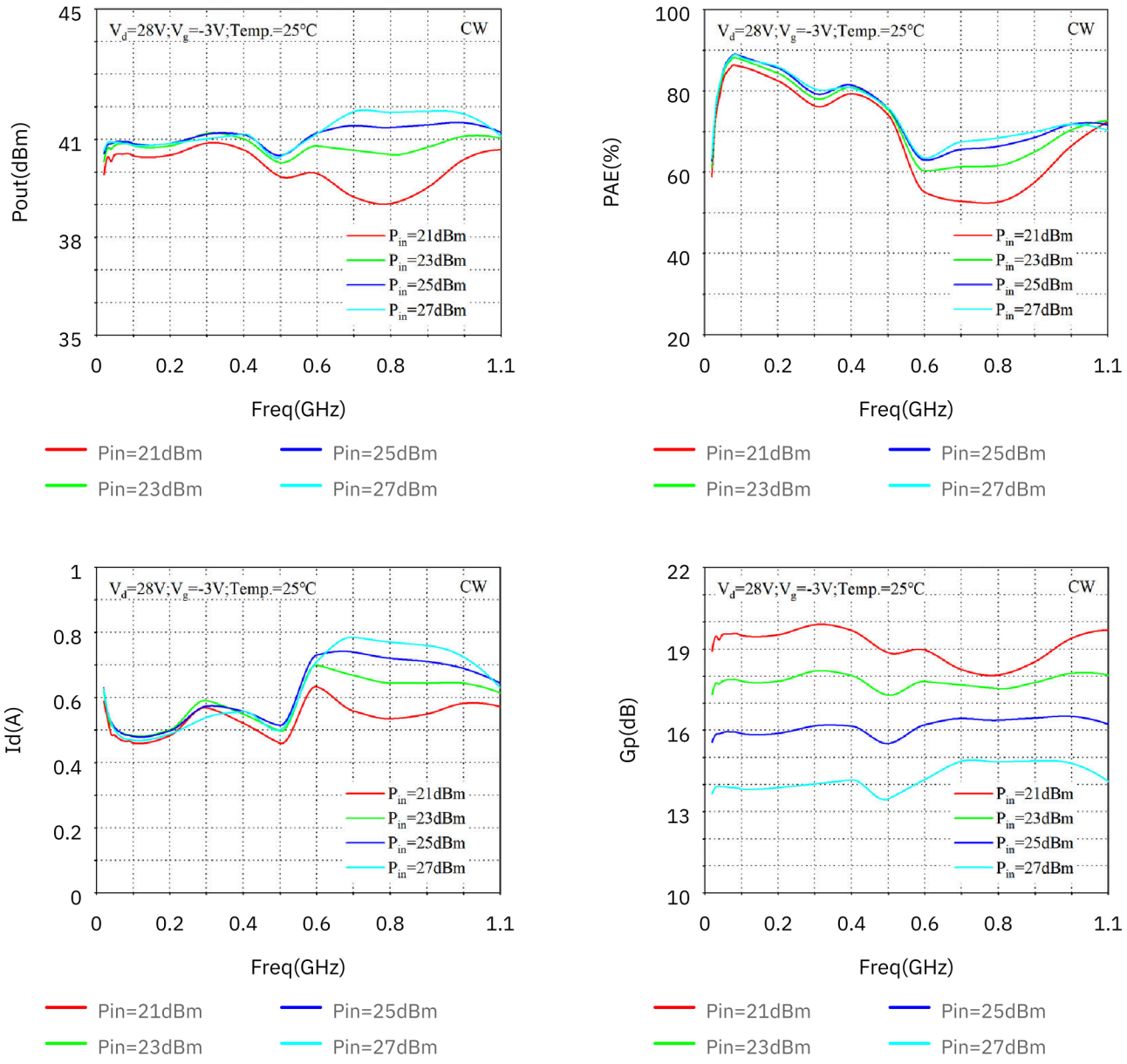
Desenho dimensional mecânico

Desenho parcial com as dimensões confirmadas em mm. Para a instalação, consulte o desenho completo de instalação.



Curvas de desempenho

Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.



Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente de dreno; Ganho de potência. Vd = 28 V; Vg = -3 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 21/23/25/27 dBm.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.